PISMENI ISPIT IZ ELEKTRONIKE 1

ZADATAK 1. Koncentracije primjesa na n i p strani diode iznose $N_D = 5\cdot 10^{15}$ cm⁻³ i $N_A = 2\cdot 10^{17}$ cm⁻³. Vrijedi $L_p << w_n$ i $L_n >> w_p = 1$ µm. Parametri manjinskih nosilaca su $\mu_n = 550$ cm²/Vs, $\mu_p = 350$ cm²/Vs, $\tau_p = 1$ µs. Površina pn spoja iznosi S = 5 mm². Temperatura je T = 300 K. Pretpostaviti m = 1.

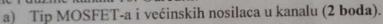
a) Izračunati struju zasićenja (3 boda).

b) Izračunati struju kroz diodu uz priključen propusni napon' U=0,55 V (2 boda).

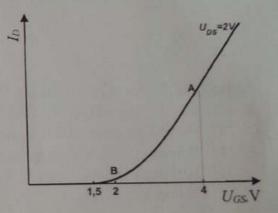
c) Izračunati rubne i ravnotežne koncentracije te nacrtati raspodjele manjinskih nosilaca za zadani propusni napon i označiti sve karakteristične vrijednosti (4 boda).

d) Izračunati dinamički otpor uz zadani napon (1 bod).

ZADATAK 2. Prijenosna karakteristika nekog idealnog MOSFET-a (λ≈0) prikazana je na slici. Debljina oksida iznad kanala je 0,06 μm, pokretljivost nosilaca u kanalu je 350 cm²/Vs, a omjer širine i dužine kanala 10. Odrediti:

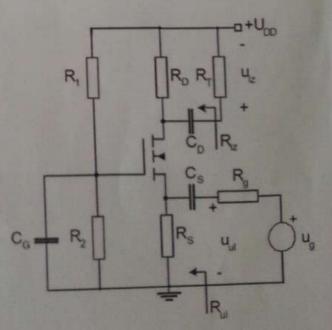


- b) Napon praga i strujni koeficijent (2 boda).
- c) Područje rada i struju u točki A (2 boda).
- d) Dinamičke parametre g_m , r_d i μ u točki A (2 boda).
- e) Dinamičke parametre u točki B (2 boda).



ZADATAK 3. U pojačalu sa slike zadano je $U_{DD}=15$ V, $R_g=500~\Omega$, $R_1=2~\mathrm{M}\Omega$, $R_2=820~\mathrm{k}\Omega$, $R_T=6.8~\mathrm{k}\Omega$ i $R_D=2.7~\mathrm{k}\Omega$. Parametri n-kanalnog MOSFET-a su $K=2.2~\mathrm{mA/V^2}$, $U_{GS0}=1~\mathrm{V}$ i $\lambda=0.0041~\mathrm{V^{-1}}$.

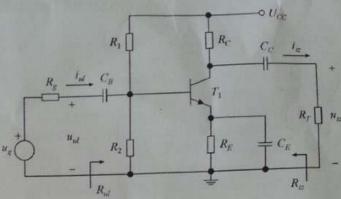
- a) Odrediti otpor R_S da struja I_{DQ} iznosi 2 mA. Pri proračunu zanemariti porast struje odvoda u zasićenju. Izračunati napon U_{DSQ} (2 boda).
- Nacrtati nadomjesnu shemu pojačala za dinamičku analizu (1 bod).
- c) Izvesti izraz i izračunati naponsko pojačanje $A_V = u_G/u_{sd}$ (3 boda).
- d) Izvesti izraz i izračunati ulazni otpor R_{sd} (2 boda).
- e) Izvesti izraz i izračunati izlazni otpor R (2 boda).



ZADATAK 4. Za pojačalo na slici zadani su sljedeći podaci: $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 5.6 \text{ k}\Omega$, $R_E = 2 \text{ k}\Omega$, $R_C = 2 \text{ k}\Omega$, $R_T = 2 \text{ k}\Omega$, $R_S = 50 \Omega$, $U_{CC} = 12 \text{ V}$. Parametri npn tranzistora su $\beta \approx hfe = 100$, $U_{\gamma} = 0.7 \text{ V}$. Naponski ekvivalent temperature $U_T = 25 \text{ mV}$.

a) Odrediti statičku radnu točku (*Uceq, Icq*),
strminu i dinamički otpor u radnoj točki (2 boda).

 Skicirati statički i dinamički radni pravac, označiti karakteristične točke i odrediti maksimalni hod izlaznog napona u_{i:} (3 boda).



c) Nacrtati nadomjesnu shemu za dinamičku analizu te izvesti izraz i izračunati naponsko pojačanje $A_{Vg} = u_{iz}/u_g$ (4 boda).

d) Odrediti signal generatora $U_{g,max}$ za koji se dobije maksimalni izlazni signal bez izobličenja (1 bod).

ZADATAK 5. Na slici je prikazan sklop s idealnim operacijskim pojačalima. Vrijednosti otpornika su: $R_1 = 2.7 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 1.8 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 3.6 \text{ k}\Omega$, $R_4 = 560 \Omega$, a ulazna je struja $i_{ul} = 1 \sin \omega t \text{ mA}$.

- a) Odrediti ovisnost izlazne struje i_{izl} o ulaznoj struji i_{ul} (5 bodova).
- b) Odrediti ovisnost izlaznog napona u_{izl} o ulaznoj struji i_{ul} (1 bod).
- c) Izračunati izlaznu struju $i_{i:l}$ i izlazni napon $u_{i:l}$ za slučaj $R_T=1$ k Ω te za slučaj $R_T=3,3$ k Ω (4 boda).

